This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.



BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Offenlegungsschrift

(5) Int. Cl.8; H 03 B 5/30

© DE 196 34 622 A 1

DEUTSCHES

PATENTAMT

196 34 622.3 Aktenzeichen: 27. 8.96 2 Anmeldetag: (3) Offenlegungstag:

12, 3.98

(71) Anmelder:

Siemens Matsushita Components GmbH & Co. KG, 81541 München, DE

(4) Vertreter:

Fuchs, F., Dr.-Ing., Pat-Anw., 81541 München

(72) Erfinder:

Glas, Alexander, 81735 München, DE

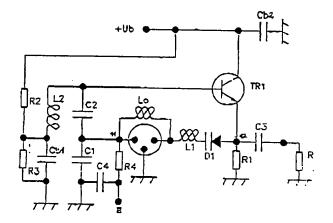
Entgegenhaltungen:

38 27 226 A1 50 43 681 US US 45 81 592

MATTHYS, Robert J.: Crystal Oscillator Circuits New York (u.a.): John Wiley 8 Sons, 1983, S. 61-64

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

- (A) In seiner Resonanzfrequenz abstimmbarer Butler-Oszillator
- Butler-Oszillator mit einem frequenzbestimmenden OFW-Resonator (10) und einem in Serie zum OFW-Resonator (10) liegenden Serienresonanzkreis (L1, D1) zur Oszillatorfrequenzānderung.



196 34 622 DE

Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft einen Butler-Oszillator nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.

Als Emitterfolger ausgebildete Butler-Oszillatoren sind aus dem Buch "Cristal Oscillator Circuits" von Robert J. Matthys, John Wiley & Sons, 1983, Seiten 61 bis 64 bekannt

Anhand von Fig. 1 werden nachfolgend die bekannten Teile eines Butler-Oszillators der gattungsgemäßen 10 Art beschrieben

Der Oszillator enthält als aktives Element einen als Emitterfolger geschalteten Transistor TR1. Die Basis dieses Transistors TR1 liegt über die Reihenschaltung einen dieser parallel liegenden kapazitiven Teiler C2, C1 an Masse. Der Verbindungspunkt zwischen der Induktivität L2 und der Kapazität Cb1 liegt am Verbindungspunkt eines ohmschen Spannungsteiler R2, R3, der seinerseits zwischen einer Betriebsspannung + Ub und 20 Masse liegt. Der Kollektor des Transistors TR1 liegt direkt an der Betriebsspannung +Ub und über eine Kapazitat Cb2 an Masse. Der Emitter des Transistors TRI liegt über einen Widerstand R1 sowie eine diesem parallel liegende Reihenschaltung aus einer Kapazität 25 C3 und einem Widerstand RL an Masse. Der Widerstand RL stellt die HF-Last des Oszillators dar.

Das die Oszillatorfrequenz bestimmende Element wird durch einen Resonanzkreis 10 gebilder, der in einem Rückkoppelkreis vom Emitter-Schaltungsknoten 30 12- auf die Basis des Transistors TR1 liegt. Ein Schaltungsknoten 11 am Resonanzkreis 10 liegt am Verbindungspunkt des kapazitiven Teilers C2, C1.

Im bekannten Butler-Oszillator nach der eingangs genannten Druckschrift wird der Resonanzkreis durch ei- 35 nen Schwingquarz mit parallel liegender Induktivität gebildet, die die interne Parallelkapazität des Schwingquarzes kompensiert

Soll bei einem derartigen bekannten Oszillator die Resonanzfrequenz geändert oder eine Frequenzmodu- 40 lation durchgeführt werden, so muß dies durch Verstimmen des aktiven Oszillatorteils - Verstärker, Rückkopplung, Ausgangskreis - realisiert werden. Dies führt zu einer leichten Verschiebung der Oszillatorfrequenz Das Verändern des Rückkoppelnetzwerks ist nur 45 im geringem Maße möglich, da sich dadurch auch das Rückkopplungsverhältnis ändert, was zu Oszillatorinstabilitäten führt. Der erzielbare Frequenzhub ist vergleichsweise gering.

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zu- 50 grunde, einen Oszillator der in Rede stehenden Art mit großem Frequenzhub anzugeben.

Diese Aufgabe wird bei einem Butler-Oszillator der eingangs genannten Art erfindungsgemäß durch die Maßnahmen des kennzeichnenden Teils des Patentan- 55 spruchs 1 gelöst.

Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand von Unteransprüchen.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines Ausführungsbeispiels gemäß den Figuren der Zeichnung 60 derohmig ausgebildet. näher erläutert. Es zeigt:

Fig. 1 das bereits teilweise erläuterte Schaltbild eines Emitterfolger-Butler-Oszillators; und

Fig. 2 ein Ersatzschaltbild eines im Oszillator nach Fig. 1 vorgesehenen frequenzbestimmenden mit akusti- 65 schen Oberflächenwellen arbeitenden Resonators -OFW-Resonator -

Erfindungsgemäß ist der frequenzbestimmende Kreis

10 nach Fig. 1 als OFW-Resonator ausgebilder. Derartige OFW-Resonatoren sind an sich bekannt und müssen daher hier nicht näher erläutert werden. Lediglich beispielsweise sei hier angegeben, daß ein derartiger OFW-Resonator etwa durch zwei Interdigitalwandler und zwei die akustische Spur dieser Interdigitalwandler abschließende Reflektoren gebildet sein kann.

Gemäß Fig. 1 liegt der OFW-Resonator am Schaltungsknoten 11 über einen Widerstand R4 an einem Eingang E für ein Modulationssignal, wobei der Verbindungspunkt zwischen dem Widerstand R4 und dem Eingang E über eine Kapazität C4 an der Kapazität C1 bzw. Masse liegt

Gemäß einem weiteren Merkmal der Erfindung liegt einer Induktivität L2 und einer Kapazität Cb1 sowie 15 in Reihe zum OFW-Resonator 10 ein durch eine Induktivität L1 und eine Kapazitätsdiode D1 gebildeter steuerbarer Resonanzkreis, der auf der Seite der Kapazitātsdiode D1 am Schaltungsknoten 12 bzw. am Emitter des Transistors TR1 liegt.

In Weiterbildung der Erfindung liegt parallel zum OFW-Resonator 10 eine Induktivität L0.

Aus Fig. 2 ist das elektrische Ersatzschaltbild des OFW-Resonators nach Fig. 1 ersichtlich. Es wird durch die Reihenschaltung einer Induktivität Lm, eines ohmschen Widerstandes Rm und einer Kapazität Cm sowie eine dieser Reihenschaltung parallel liegende Kapazität C0 gebilder

Beim erfindungsgemäßen Oszillator handelt es sich also um einen Butler-Oszillator mit einem OFW-Resonator als frequenzbestimmendem bzw. frequenzstabilisierendem Element. Die Resonanzfrequenz des OFW-Resonators ist durch den einen Ziehkreis bildenden steuerbaren Resonanzkreis aus der Induktivität L1 und der Kapazitätsdiode D1 über eine Modulationsspannung am Eingang E elektrisch einstellbar. Der dabei erzielbare Frequenzhub liegt bei mehr als 100 KHz. Die Möglichkeit, eine Frequenzmodulation mit einem hohen Frequenzhub zu betreiben, verbessert den Verstärkungsgewinn bei der Demodulation in einem Empfanger, was eine höhere Störsicherheit zur Folge hat.

Darüber hinaus können mit einem großen Frequenzhub hohe Modulationsfrequenzen von mehr als 100 KH2 sicher übertragen werden. Da die Resonanzfrequenz direkt durch den elektrisch abstimmbaren Ziehkreis L1, D1 verändert werden kann, kann auch die Oszillatorfrequenz in schnellem Wechsel geändert werden, ohne daß ein immer wieder neuer Einschwingvorgang stattfinden muß.

Der vorstehend beschriebene Oszillator arbeitet in Emitterfolger-Grundschaltung nahe bei der Serienresonanz des OFW-Resonators. Die Verstärkung des Emitterfolgers ist 1, wobei die Verstärkung in der Oszillatorschleife durch die Induktivität L2 und die Kapazität C2 eingestellt wird, die einen Serienresonanzkreis mit einer Serienresonanzfrequenz nahe bei der Frequenz des OFW-Resonators bilden. Um die Betriebsgröße des Schaltungsteils aus OFW-Resonator 10 und Ziehkreis L1, D1 hochzuhalten, ist der Anschluß am Emitter des Transistors TR1 und am kapazitiven Teiler C2, C1 nie-

Der Ziehkreis ist für die Oszillatorfrequenz mit nicht zu kleiner Kapazität der Kapazitätsdiode D1 dimensioniert Die Kapazität CO des OFW-Resonators 10 wird durch die parallel liegende Induktivität LO kompensiert, so daß eine Serienschaltung des frequenzfesten OFW-Resonators 10 und des elektrisch abstimmbaren Ziehkreises L1, D1 gewährleistet ist

4

DE 196 34 622 A1

3

Patentansprüche

1. Butler-Oszillator mit einem als Emitterfolger geschalteten Oszillatortransistor (TR1) und einem frequenzbesummenden Rückkopplungskreis (10) vom Ausgang auf den Eingang des Oszillatortransistors (TR1), dadurch gekennzeichnet, daß der frequenzbestimmende Rückkopplungskreis (10) ein mit akustischen Oberflächenwellen arbeitender Resonator - OFW-Resonator - ist und daß in 10 Serie zum OFW-Resonator (10) ein steuerbarer Resonanzkreis (L1, D1) liegt 2 Butler-Oszillator nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der steuerbare Resonanzkreis (L1, D1) durch die Serienschaltung einer Induktivi- 15 tät (L1) und Kapazitätsdiode (D1) gebildet ist. 3. Butler-Oszillator nach Anspruch 1 und/oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß dem OFW-Resonator (10) eine Induktivität (L0) parallel geschaltet ist.

Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen

20

25

30

35

40

45

50

*5*5

60

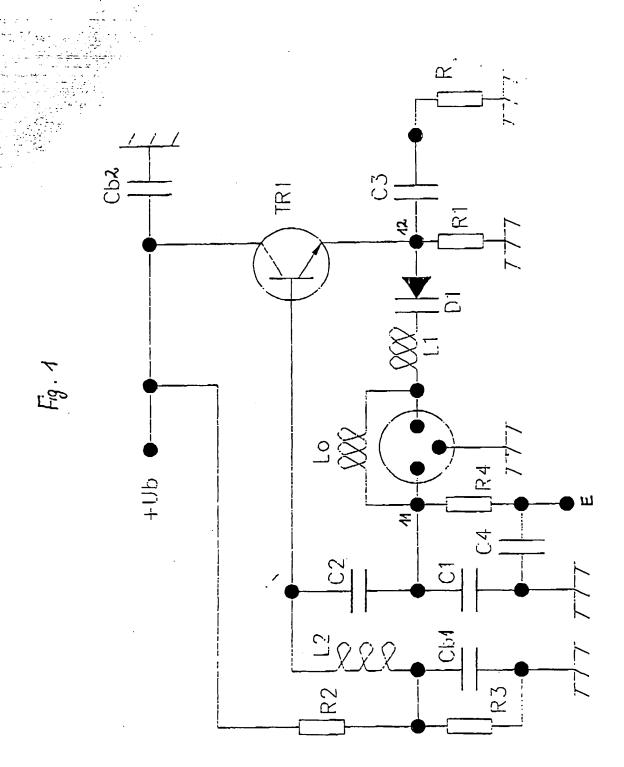
- Leerseite -

ZEICHNUNGEN SEITE 1

Nummer: Int. Cl.⁶;

Offenlegungstag:

DE 196 34 622 A1 H 03 B 5/30 12. Mārz 1998



ZEICHNUNGEN SEITE 2

Nummer: Int. Cl.⁶:

Offenlegungstag:

DE 196 34 622 A1 H 03 B 5/30 12 Mārz 1998

Fig. 2

